

増設メモリ

増設メモリ

1. 機能仕様

型名	N8102-273	N8102-274	N8102-275	N8102-276
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	8GB (4GBx2 枚)
仕様	DDR2-667(PC2-5300) FB-DIMM, Advanced Memory Buffer, ECC			
動作クロック	333MHz(差動)			
駆動電圧	1.5V/1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-269	N8102-270	N8102-271	N8102-272
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	8GB (4GBx2 枚)
仕様	DDR2-667(PC2-5300) FB-DIMM, Advanced Memory Buffer, ECC			
動作クロック	333MHz(差動)			
駆動電圧	1.5V/1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-277	N8102-278	N8102-279	N8102-280
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	8GB (4GBx2 枚)
仕様	DDR2-667(PC2-5300) FB-DIMM, Advanced Memory Buffer, ECC			
動作クロック	333MHz(差動)			
駆動電圧	1.5V/1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-246	N8102-247	N8102-248	N8102-249
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	8GB (4GBx2 枚)
仕様	DDR2-533(PC2-4300) FB-DIMM, Advanced Memory Buffer, ECC			
動作クロック	266MHz(差動)			
駆動電圧	1.5V/1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-250	N8102-251	N8102-252
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR2-533(PC2-4300) FB-DIMM, Advanced Memory Buffer, ECC		
動作クロック	266MHz(差動)		
駆動電圧	1.5V/1.8V		
バッファ	有		

型名	N8102-254	N8102-255	N8102-256	N8102-257
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	8GB (4GBx2 枚)
仕様	DDR2-533(PC2-4300) FB-DIMM, Advanced Memory Buffer, ECC			
動作クロック	266MHz(差動)			
駆動電圧	1.5V/1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-289	N8102-290
容量	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR2-667(PC2-5300) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC	
動作クロック	333MHz(差動)	
駆動電圧	1.8V	
バッファ	無	

型名	N8102-285	N8102-286	N8102-287
容量	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)	2GB (2GBx1 枚)
仕様	DDR2 667(PC2-5300) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	333MHz(差動)		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	無		

型名	N8102-227	N8102-228	N8102-229
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2-4300) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	266MHz(差動)		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	無		

型名	N8102-224	N8102-225	N8102-226
容量	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)	2GB (2GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2-4300) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	266MHz(差動)		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	無		

型名	N8102-242	N8102-243
容量	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2-4300) SDRAM-DIMM,Unbuffered	
動作クロック	266MHz(差動)	
駆動電圧	1.8V	
バッファ	無	

型名	N8102-213	N8102-214	N8102-215
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR400(PC3200) SDRAM-DIMM,Unbuffered,ECC		
動作クロック	200MHz(差動)		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		

型名	N8102-216	N8102-217	N8102-218	N8102-219
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	8GB (4GBx2 枚)
仕様	DDR2 400(PC2-3200) SDRAM-DIMM, Registered,ECC			
動作クロック	200MHz(差動)			
駆動電圧	1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-231	N8102-232	N8102-233
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR2 400(PC2-3200) SDRAM-DIMM, Registered, ECC		
動作クロック	200MHz(差動)		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	有		

型名	N8102-235	N8102-236
容量	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR2 400(PC2-3200) SDRAM-DIMM,Registered, ECC	
動作クロック	200MHz(差動)	
駆動電圧	1.8V	
バッファ	有	

型名	N8102-189	N8102-190	N8102-191	N8102-192
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	166MHz(差動)			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-193	N8102-194	N8102-195	N8102-196
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	166MHz(差動)			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-197	N8102-198	N8102-199	N8102-200
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	166MHz(差動)			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-183	N8102-184	N8102-185
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM, Registered, ECC		
動作クロック	133MHz(差動)		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	有		

2. 用語集

■DIMM(Dual Inline Memory Module)

表と裏の Pin の信号が異なるメモリモジュールの形態。最近のメモリモジュールの殆どがこの形態をとる。1枚あたり64ビット幅(ECC用bitは除く)のデータ転送を行なう物が一般的である。

■FB-DIMM(Fully Buffered DIMM)

DRAMモジュール規格の一種。モジュール上にAMB(advanced memory buffer)と呼ばれるパラレル-シリアル交換LSIを搭載する事で「DDR2」などのDRAMを使いつつ、モジュール間のインターフェースをシリアル化したものです。

■SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)

外部バスインターフェイスが一定周期のクロック信号に同期して動作するように改良されたDRAMです。

■DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

外部クロックの2倍の周期でデータをやり取りできるようにしたSDRAM。SDR SDRAMが外部クロックの立ち上がりに同期してデータを転送するのに対し、DDR SDRAMはクロックの立ち上がりと立ち下がりの両方を利用し、同じクロック周波数で2倍のデータ転送を実現します。

■SDR SDRAM(Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

クロック信号の1周期の間に1回データ転送を行なうSDRAM。
DDR SDRAMが登場する以前に主流だったSDRAMを表す用語です。

■ECC(Error Correcting Code)

記憶装置などからデータを読み出す際、データの誤りを訂正するために本来のデータとは別に付加される冗長なデータのこと。また、そのような機能のこと。高い信頼性が求められるサーバ機などの記憶装置やバス(データ伝送路)に利用されます。

■Chipkill

ECC付きのDIMM使用時に、一個のDRAM内のエラーを訂正する機能(但し、一般的に一つのストローク信号で動作する4bit分までのエラー訂正までなのが一般的です。)

■Dual Channel

Dual Channelとは、メモリとメモリコントローラ間を、二本のバスを使って接続して2枚のメモリモジュールを同時にコントロールします。Single Channel時と比較した場合、一度に処理できるデータ量が2倍(理論値)になります。ただし、使用するメモリモジュールは同一使用の製品とする必要があります。

3. 注意事項

- ・ Express5800 シリーズ用に販売されている他社製メモリは動作保証の範囲外となるため、Express5800 純正品のメモリを使用すること。